

スパッタ装置



機種名

芝浦メカトロニクス CFS-4ES(S)
2006年度購入

特徴

- 金属，絶縁体の薄膜を基板上に成膜できます。
- 真空チャンバ内に，アルゴンガス，酸素ガス，窒素ガスを導入可能です。

【主な仕様】

- ・ターゲットサイズ: ϕ 3インチ×3個
- ・ターゲット種: SiO₂, Mo(その他のターゲットは別途ご用意ください)
- ・基板サイズ: 最大 ϕ 180mm
- ・方式: サイドスパッタ
- ・スパッタ電源: 500W 高周波電源
- ・排気系: ターボ分子ポンプ+油回転ポンプ
- ・基板加熱: 不可

【代表的なターゲットのスパッタレート】

Au	50nm/min
Al	27nm/min
Cr	20nm/min
Mo	25nm/min
Pt	32nm/min
Ti	14nm/min(以上, RF電力:300W, アルゴンガス圧力:0.5Pa)
SiO ₂	16nm/min(RF電力:400W, アルゴンガス圧力:0.5Pa)

料金等

施設開放: 1,200 円/ 時

操作法説明: 3,900 円(1時間)

※その他、基礎～応用まで別途相談承ります。

研究員による支援

3,900 円 / 時

試作の支援・指導

機器操作など

ご利用申し込みは実施日の前日まで可能です。